80

EE-410

3ª. Prova de Avaliação

17/05/07

- 1) Calcule a barreira de potencial numa junção com N_A=10¹⁷cm⁻³ e N_D=10¹⁶cm⁻³. Calcule os limites da região de depleção, com V_a=0, 500mV e -10V. Qual o valor do campo elétrico no ponto de máximo(V_a=0)? Onde se encontra esse ponto?
- 2) Usando a aproximação de diodo curto, calcule a corrente de saturação, usando os valores de W_{PP}=W_{NN}=5μm. Estime a tensão de ruptura por "punch-through" na junção descrita acima.
- 3) Calcule nesta junção a corrente com uma tensão de polarização de 500mV. Qual o valor das correntes de elétrons e lacunas, respectivamente?
- Na questão anterior, é possível calcular a resistência elétrica de cada camada e estimar a queda de potencial entre a junção e o ponto de contato. Quais são os valores? Observe que as quedas de potencial se referem somente aos portadores majoritários (lacunas em P e elétrons em N), pois as correntes de minoritários se dão por difusão.
- 5) As junções tipo "diodo curto" e "diodo longo" tem mecanismos próprios de ocorrência da ruptura em polarização inversa. Quais são eles?

Valores:

$$A=1 \text{mm}^2$$

$$n_i^2 = 10^{20} cm^{-6}$$

$$U_T=25mV$$

$$D_n=25 \text{cm}^2/\text{s}$$

$$U_T = 25 \text{mV}$$
 $\cdot D_n = 25 \text{cm}^2/\text{s}$ $D_p = 12,5 \text{cm}^2/\text{s}$

$$\varepsilon_{\rm s} = 12 \cdot 8,85 \cdot 10^{-14} \, \text{F/cm}$$

$$D/\mu=U_T$$
 $\rho=1/\sigma$

$$\rho = 1/c$$

$$U_T=25mV$$

Fórmulas gerais:

$$\Phi = V_N - V_P = U_T \cdot ln \frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2}$$

$$W_{t} = \sqrt{\frac{2 \varepsilon_{S} (\Phi - V_{a})}{q} \cdot \frac{N_{A} + N_{D}}{N_{A} N_{D}}}$$

$$I(V_a) = I_S \cdot \left[\exp \frac{V_a}{U_T} - 1\right]$$

$$E_M = \frac{Q_t}{\epsilon_S} = \frac{q N_A W_P}{\epsilon_S} = \frac{q N_D W_N}{\epsilon_S}$$

$$W_t = \sqrt{\frac{2\,\epsilon_S\left(\Phi\text{-}V_a\right)}{q}\,\cdot\,\frac{N_A + N_D}{N_A\,N_D}} \qquad \qquad I_S \approx q\,\,n_i^{\,2}\,A\,\left[\!\left[\frac{D_n}{N_A\cdot\,W_{PP}} + \frac{D_p}{\left[N_D\right\cdot\,W_{NN}}\right]\!\right] \label{eq:Wt}$$

$$I\left(V_{a}\right) = I_{S} \cdot \left[\exp \frac{V_{a}}{U_{T}} - 1\right] \qquad \sigma \text{ (condutividade)} = \frac{J_{DER}}{E} = q\left(\mu_{n} \, \overline{n} + \mu_{p} \, \overline{p}\right)$$

$$M = \frac{75}{25\cdot10^3}$$
 Lis







